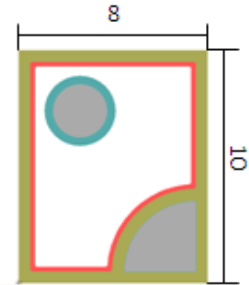




紫光 LED 芯片规格说明书 (产品规格型号: ZW-0810U 方片)

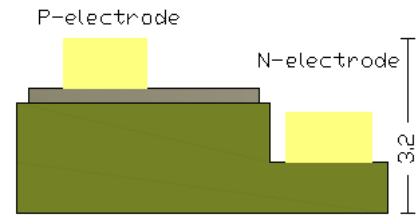
◆ 产品特点

- 高亮度、长寿命
- 芯片百分之百测试分选
- 波长和光强良好的一致性



◆ 物理参数

结构	nGaN/GaN structure on sapphire EPI wafer
P、N 电极	Au
芯片尺寸	8mil×10mil(200±5μm×250±5μm)
芯片厚度	3.15mil(80±5μm)
焊盘尺寸	2.95mil(75±5μm)



单位: mil

◆ 光电特性 (380nm-385nm, $I_F=20\text{mA}$, $T_c=22^\circ\text{C}$)

性能参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值
正向电压 (V)	V_F	$I_F=20\text{mA}$	3.0	3.1	3.2
			3.2	3.3	3.4
			3.4	3.6	3.8
反向电流 (μA)	I_R	$V_R=5\text{V}$	0	≤ 0.1	0.2
波长范围 (nm)	λ_P	$I_F=20\text{mA}$	380	382.5	385
最大电流 (mA)	I_{MAX}	DC	30		

◆ 光功率范围 (380nm-385nm):

光功率范围	I_1	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
I_v 范围 (mw)	...	5~10	10~15	15~20	20~25	...



◆ 光电特性 (385nm-420nm, $I_F=20\text{mA}$, $T_c=22^\circ\text{C}$)

性能参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值
正向电压 (V)	V_F	$I_F=20\text{mA}$	3	3.1	3.2
			3.2	3.3	3.4
			3.4	3.6	3.8
			3.0	3.2	3.4
反向电流 (μA)	I_R	$V_R=5\text{V}$	0	≤ 0.1	0.2
波长范围 (nm)	λ_p	$I_F=20\text{mA}$	385	402.5	420
最大电流 (mA)	I_{MAX}	DC	30		

◆ 光功率范围 (385nm-420nm):

光功率范围	I_1	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7
I_V 范围 (mw)	...	5~8	8~11	11~14	14~17	17~20
光功率范围	I_8	I_9	I_{10}			
I_V 范围 (mw)	20~23	23~26	...			

- 封装工艺的温度不得超过 220°C 。
- 该产品是一级防静电元件，产品传输和封装过程中应有静电保护。
- 亮度值是基于西安中为裸芯测试台。
- 可根据客户要求定做特殊规格的芯片。